排他的制御方式単インダクタ4出力降圧形 DC-DC 電源

小堀康功* 熊倉大地(小山工業高等専門学校)

築地伸和 呉澍 シャイフルニザム 高井伸和 小林春夫(群馬大学)

Single-Inductor Four-Output DC-DC Buck Converter with Exclusive Control

Yasunori Kobori^{*}, Daichi Kumakura (National College of Technology, Oyama College)

Nobukazu Tsukiji, Shu Wu, Nizam M. Shaiful, Nobukazu Takai, Haruo Kobayashi (Gunma University)

キーワード: DC-DC コンバータ,単インダクタ・マルチ出力 SIMO 電源,降圧形電源,4出力電源

(Keywords, DC-DC Converter, SIMO Converter, Buck Converter, Four-output Converter)

1. はじめに

近年の電子機器では、更なる小型・軽量・省電力化 の研究開発が進められている。スイッチング電源では 集積が困難なインダクタ等の電子部品の削減や、内部 回路の削減による LSI の小型化も検討されている。

これまで我々は、単インダクタ・マルチ出力 SIMO (Single-Inductor Multi-Output) DC-DC 電源^{1~3)} によ りインダクタ等の削減を検討し、さらに4出力スイッ チング電源のシミュレーション結果を報告してきた。 今回、4出力 SIMO 降圧形スイッチング電源を実装確認 したので報告する。

2. 単インダクタ・マルチ出力降圧形電源

2.1 降圧形 SIMO 電源の基本構成と動作原理

4出力 SIMO 降圧形スイッチング電源の構成を、図 1に示す。パワーステージ部に4個のサブコンバータ を接続し、排他的 Exclusive に一つのサブコンバータを 選択制御する。パワーステージであるメインコンバー タ部は、メインスイッチ・還流ダイオード・インダク タで構成される。制御部は、鋸歯状波発生回路および サブコンバータを排他的に選択する Exclusive 制御回 路で構成される。

各サブコンバータは同一構成であり、サブスイッ チ・大容量コンデンサ・誤差電圧増幅器・PWM 信号発 生器および選択信号 SEL 発生部で構成され、基準電圧 のみがそれぞれ異なる。

次に動作を説明する。各サブコンバータでは、共通 の鋸歯状波により同期した PWM 信号を発生する。こ れらの PWM 信号はパワーステージで論理和され、メ インスイッチを制御駆動する。一方、サブコンバータ の排他的選択方法は、増幅誤差電圧が最大のサブコン バータを選択する Exclusive 方式を採用する。この方式 として、各増幅誤差電圧を相互にコンパレータで比較 する方式も考えられるが、サブコンバータ数のフレキ シビリティに対応しにくい。そこで、図2のように、 各サブコンバータの△Vをパワーステージ部に送り、 ワイヤード OR 回路により最大の増幅誤差電圧△VMAX を検出して、この△VMAXを各サブコンバータに送り返 すことにより、サブコンバータ内でセルフ選択できる 方式とした。

以上の構成により、基本的に1つのサブコンバータ内 の選択信号 SEL のみが H となり、内部のサブスイッチ を ON にできる。次の周期には∠VMAX が変化して、新 たなサブコンバータが選択制御される。このようにし て鋸歯状波の立上り端、つまりは PWM 信号の立上り 端で、次周期の制御対象を排他的に選択する



図1 4出力 SIMO 方式降圧形スイッチング電源の構成



図2 最大誤差電圧検出用ワイヤード OR 回路

2.2 SIMO 電源のシミュレーション結果

提案する4出力降圧形 SIM0 電源のシミュレーション 回路の主要パラメータを表1に、シミュレーション結 果の出力電圧を図3に、選択信号 SEL 等の主要波形を 図4に示す。表1では各サブコンバータの主要パラメ ータを同一とし、出力電圧を Vo=6.0~4.5V に、出力負 荷電流をそれぞれ Io=0.5A とした。

図3の定常特性では出力電圧は安定であり、制御回路に施された位相遅れ補償により基本的にオフセットは発生していない。図4に、各サブコンバータのSEL信号(S1~S4)と、回生ダイオードに流れる回生電流Irを示した。各SEL信号は識別可能なように、レベル差を付けて表示している。ここで、4つのSEL信号が排他的に1個ずつ現れているが、図中の星印周期ではSEL信号がなく、どのサブコンバータも選択されていない。この場合、図1の回路においてインダクタと並列に接続された回生ダイオード(〇印)が導通し、図4に示すように回生電流が流れていることが分かる。なお、4出力を考慮して、クロック周波数は500kHzとした。

表1 シミュレーショ	ン回路の主要パラメータ
------------	-------------

Vin	10.0 V
V_1	6.0 V
V_2	$5.5~{ m V}$
V_3	$5.0~{ m V}$
V_4	$4.5~\mathrm{V}$
Io	各 0.5 A
L	0.2 μH
С	470 μ F
Fck	$500 \mathrm{kHz}$







図5に負荷電流変Io1とIo4をそれぞれ2倍(0.5A ⇔ 1.0A) に変化させた場合の過渡応答特性(ロードレギ ュレーション)を、定常リプルと共に拡大して示す。 定常時の各出力リプルは安定であり、電流増加時にや や大きくなるが20mVpp 未満と、出力電圧の0.5%以下 で問題ない。一方、負荷電流変化∠Io=0.5A に対する過 渡応答特性では、セルフ・レギュレーションおよびク ロス・レギュレーションは共にオーバー/アンダー・ シュートとも±5mV程度であり良好な特性である。

次に、入力電圧の変化に対する出力電圧の応答特性 (ラインレギュレーション)を図6に示す。ここでは、 入力電圧10Vに対して±10%の電圧変化△Vi=1.0Vと した。各出力リプルのレベルはほぼ一定である。一方、 動特性ではオーバー/アンダー・シュート共に検知す ることができず、ラインレギュレーション特性は非常 に良好である。



5.515 5.51 5.505 V2 5.5 5.495 5.49 5.485 5.02 5.015 V3 5.01 5.005 4.998 4.99 4.985 4.52 **V4** 4.515 4.51 4.505 4.5 4.495 4.49 4.49 11.2 11-10.8-10.6-10.4-10.2-10.2-Vi 9V 10 9.8 9.6 9.4 9.2 9.2 11V 10V [ms]

図6シミュレーション結果 (ラインレギュレーション)

3. 降圧形 SIMO 電源の実装結果

3.1 基本構成と実装写真

マルチ出力降圧形スイッチング電源の製作にあたり、 サブコンバータの増減が可能なようにビルトイン方式 を採用した。つまり図1の回路構成において、マザー ボード上にパワーステージ回路および制御回路部を全 て作製し、各サブコンバータはソケット構成で着脱可 能とした。作製した SIMO 電源の写真を図7に示す。ま た、実装時の出力電圧・負荷電流および主要パラメー タを表2に示す。ここで目標電圧は、各サブコンバー タ内の基準電圧を示しており、出力オフセットはそれ ぞれ 20mV 以下であり、出力電圧の0.5%程度と非常に小 さい。また、出力電流は固定負荷抵抗で設定しており、 全体に0.2A 程度と小さめにしている。



図7 製作した降圧形 SIMO 電源

表2 実装電源の主要パラメータ

項目	目標値	実測値
Е	10.0 V	10.0 V
V_1	4.86 V	4.84 V
V_2	4.37 V	$4.35~\mathrm{V}$
V_3	$3.85~\mathrm{V}$	3.83 V
V_4	$3.42~\mathrm{V}$	3.43 V
I_1, I_2		$0.22\mathrm{A}$
I_3 , I_4		$0.17\mathrm{A}$
L	$47 \mu H$	1.0 μ H
С	470 μ F	$470 \hspace{0.2cm} \mu \hspace{0.2cm} \mathrm{F}$
Fck	$500 \mathrm{kHz}$	$500 \mathrm{~kHz}$

3.2 実装電源の測定結果

4 出力降圧形 SIMO 電源の実測波形を図8、図9に示 す。図8は、サブ電源1の負荷電流 Io1 を切換えたと きの、サブコンバータ1のセルフ・レギュレーション およびサブコンバータ2~4のクロス・レギュレーシ ョンを示した。各定常リプルは、パルス性ノイズを除 いて40mVpp 程度とやや大きめだが、過渡応答特性では ±5mV 以下と十分小さく問題ない。

図9の定常リプルの拡大波形では、グランド配線イ ンピーダンスによるクロックに同期したパルス性ノイ ズが大きい。特に各サブコンバータの出力では、選択 直後にコンデンサが充電され始める時、つまり出力リ プルが上昇し始める時のパルスノイズが非常に大きい。 この時リプル波形がステップ上に 5~10mV 程度上昇 しているが、この原因はコンデンサの ESR (Equivalent Series Resistance:等価直列抵抗)にス テップ上にパルス電流が流入したためである。実質的 な電圧リプルは 30mVpp 程度であり、出力電圧の 0.5% 以下で問題ない。図9における実質の電圧リプルは



図8 実装 SIMO 電源の定常出力リプル



図9 実装 SIMO 電源の拡大出力リプル

30mVpp 程度であり、いずれも出力電圧の 0.5%以下で 問題ない。一方、各リプルの電圧上昇時間はそれぞれ 1 周期であり、その結果生じるピーク位相をみると、 V1 \Rightarrow V4 \Rightarrow V3 \Rightarrow V2 の順に排他的に制御されて いることが分かる。

5.まとめ

4出力降圧形 SIMO DC-DC スイッチング電源を検 討し、そのシミュレーション確認および実装回路によ り性能を測定確認した。全体構成として、メインコン バータ部と4つの同一構成のサブコンバータ方式とし、 排他的 Exclusive 制御方式とした。

シミュレーションの結果、各サブコンバータの負荷 電流を0.5Aとし、出力電圧Vo=6.0~4.5Vとしたとき、 出力電圧リプルは、それぞれ 20mVpp 以下と出力電圧 の 0.5%以下である。また、負荷電流変化⊿Io=0.5A に 対する過渡応答特性は、オーバー/アンダー・シュー トが±5mV 以下と小さく良好な応答特性である。

実装回路では、出力電圧数のフレキシビリティを考慮して、各サブコンバータを同一回路構成のプラグイン構成とした。この結果、グランド配線によるインピーダンスがやや増加して、クロックに同期したパルス性ノイズが各出力リプルに発生した。実質的な定常リプルは30mVpp程度であり、出力電圧の0.5%以下で問題ない。また負荷電流変化∠Io=0.15Aに対する過渡応答特性では、±5mV以下とまったく問題のない良好な性能である。

献

[1] Y. Kobori, M. Li, F, Zhao, S. Wu, N. Takai, H. Kobayashi, "Single-Inductor Multi-Output Converters with Four-level Output Voltages," International Conference on Circuit and System, pp.436-439 (Jun. 2014)

文

- [2] 小堀康功,高井伸和,小林春夫,他9名,"擬似 △ Σ変 調単一インダクタ2出力 DC-DC スイッチング電源, "IEEJ 電子回路研究会,ECT-12-100 (2012.12)
- [3] S. Tanaka, Y. Kobori, N. Takai, H. Kobayashi, etal, "Single-Inductor Multi-Output DC-DC Converter Design with Hysteresis Control," IEICE International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification, pp.198-203 (2013,11)